

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING

Nr 3709

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Kundförfrågningar

Semiconductor & Device Marketing Dept. A and Dept. B
Mitsubishi Electric Corporation

www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/powerdevices/

Medieförfrågningar

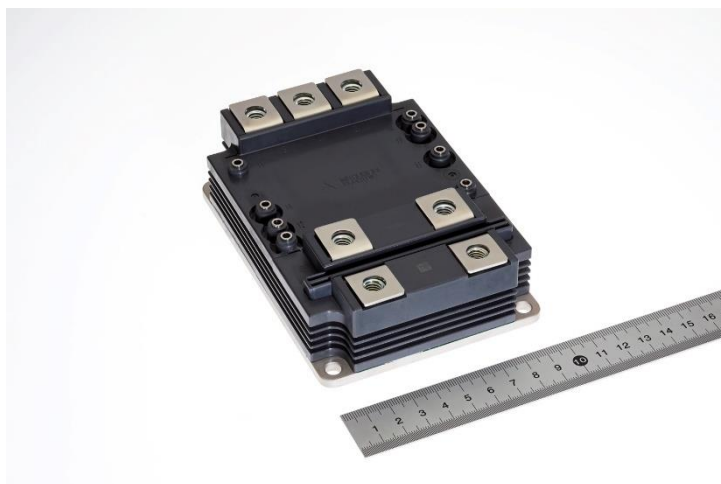
Public Relations Division
Mitsubishi Electric Corporation

prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp

www.MitsubishiElectric.com/news/

**Mitsubishi Electric levererar två nya SBD-inbäddade
SiC-MOSFET-moduler**

För extra kraftfulla högeffektiva växelriktarsystem inom järnvägsvagnar, elkraftsystem och annat



Unifull™ 3,3 kV SBD-inbäddad SiC-MOSFET-modul

TOKYO, 10 juni 2024 – [Mitsubishi Electric Corporation](https://www.mitsubishi-electric.com) (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har börjat leverera svagströmsversioner, 3,3 kV/400 A och 3,3 kV/200 A, av en Schottky-fälteffekttransistor med metalloxidhalvledare (MOSFET) i kiselkarbid (SiC) för stor industriell utrustning, inklusive fordon och elektriska kraftsystem, från och med idag den 10 juni. Tillsammans med den befintliga versionen på 3,3 kV/800 A består den nymamngivna Unifull™-serien av tre moduler för att möta det växande behovet av växelriktare som kan öka uteffekten och effektiviteten vid effektomvandling i stor industriell utrustning. De nya modulerna visas på större mässor, inklusive Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2024 i Nürnberg, Tyskland den 11 till 13 juni.

Mitsubishi Electric's SBD-inbäddade SiC-MOSFET-moduler, inklusive 3,3kV/800A-versionen som lanserades den 29 mars, har en optimerad paketstruktur som minskar omkopplingsförluster och förbättrar SiC-prestanda. Jämfört med befintliga strömmoduler minskar Unifull™-moduler omkopplingsförlusterna avsevärt och bidrar till högre uteffekt och effektivitet i stor industriell utrustning, vilket gör dem lämpliga för extra strömförsörjning i motorvagnar och drivsystem med relativt liten kapacitet.

Produktegenskaper

1) Svagströmsmoduler som lämpar sig för växelriktare med olika utgångskapaciteter

- Nya 3,3kV/400A- och 3,3kV/200A-versioner av Mitsubishi Electric's SBD-inbäddade SiC-MOSFET-modul, tillsammans med befintliga 3,3kV/800A, utgör den nya Unifull™-serien.
- De nya svagströmsmodulerna lämpar sig som extra nätaggregat i fordon och relativt små drivsystem, vilket utökar utbudet av tillämpningar för att förbättra effektiviteten i effektomvandling för växelriktare i stor industriell utrustning med varierande strömkrav.

2) SBD-inbäddade SiC-MOSFET:ar bidrar till växelriktarens uteffekt, effektivitet och tillförlitlighet

- SBD-inbäddade SiC-MOSFET:ar med en optimerad paketstruktur minskar omkopplingsförluster med 54 % jämfört med Mitsubishi Electric's befintliga strömmodul helt i kiselkarbid*, och med 91 % jämfört med företagets befintliga Si-strömmodul,** och bidrar därmed med högre uteffekt och effektivitet.
- Införandet av cellstrukturen vid bipolär modellaktivering (BMA) förbättrar överspänningskapaciteten och bidrar till förbättrad tillförlitlighet hos växelriktaren.

Huvudspecifikationer

Modell	FMF400DC-66BEW	FMF200DC-66BE
Märkspänning	3,3 kV	3,3 kV
Märkström	400 A	200 A
Isoleringsspänning	6,0 kVrms	6,0 kVrms
Anslutning	2-i-1	2-i-1
Mått (B×D×H)	100×140×40 mm	100×140×40 mm
Första leverans	Den 10 juni 2024	Den 10 juni 2024

Sortiment av Unifull™ SBD-inbäddade SiC-MOSFET-moduler

Modell	FMF800DC-66BEW	FMF400DC-66BEW	FMF200DC-66BE
Märkspänning	3,3 kV	3,3 kV	3,3 kV
Märkström	800 A	400 A	200 A
Isoleringsspänning	6,0 kVrms	6,0 kVrms	6,0 kVrms
Första leverans	Den 29 mars 2024	Den 10 juni 2024	Den 10 juni 2024

* Jämförelser mellan den nya 3,3 kV/400 A-modulen (FMF400DC-66BEW) och den befintliga strömmodulen helt i kiselkarbid (FMF375DC-66A) och den nya 3,3 kV/200 A-modulen (FMF200DC-66BE) och strömmodulen helt i kiselkarbid (FMF185DC-66A)

** Jämförelse mellan den nya 3,3 kV/400 A-modulen (FMF400DC-66BEW) och Si-strömmodulen (CM450DA-66X)

För att bidra till kontinuerlig minskning av koldioxidutsläpp finns det ett växande behov av effekthalvledare som effektivt kan omvandla elkraft, särskilt SiC-halvledare som avsevärt minskar effektförluster. Effekthalvledarmoduler för stor industriell utrustning används i effektomvandlingsutrustning, till exempel växelriktare för drivsystem och nätaggregat, DC-överföring med mera. Efterfrågan är särskilt stark för högeffekts högeffektiva SiC-moduler som ytterligare kan förbättra effektiviteten i effektomvandlingen och stödja växelriktarkonstruktioner med varierande utgångskapaciteter.

Webbplats

www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/powerdevices/

Unifull är ett varumärke som tillhör Mitsubishi Electric Corporation.

###

Om Mitsubishi Electric Corporation

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har mer än 100 års erfarenhet av att tillhandahålla tillförlitliga och högkvalitativa produkter och är en erkänd global ledare inom tillverkning, marknadsföring och försäljning av elektrisk och elektronisk utrustning som används i behandling av information och kommunikation, rymdteknik och satellitkommunikation, konsumentelektronik, industriteknik, energi-, transport- och byggutrustning. Mitsubishi Electric berikar samhället med teknik i enlighet med företagets motto, "Changes for the Better". Företaget noterade en omsättning på 5 257,9 miljarder yen (34,8 miljarder* dollar) under räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2024. Mer information finns på www.MitsubishiElectric.com

*Belopp i amerikanska dollar har omvandlats från yen till kursen 151 JPY=1 USD, den ungefärliga kursen på Tokyobörsen den 31 mars 2024.